NiCoCrAlYTa 涂层/镍基单晶高温合金界面再结晶

梁兴华^{1,2},周克崧²,刘 敏²,邓畅光²

(1. 广东工业大学,广东 广州 510081)(2. 广州有色金属研究院,广东 广州 510650)

摘 要:采用低压等离子喷涂技术在镍基单晶高温合金上制备了 NiCoCrAlYTa 涂层,通过不同的真空热处理和预处理 制度研究其对涂层/镍基单晶界面的影响。结果表明,1080 ℃真空热处理界面扩散带均产生胞状再结晶体,而1000 ℃ 和 850 ℃无再结晶产生。预处理时喷砂压力大于 0.2 MPa,在1080 ℃,6h热处理后再进行 850 ℃,24h 时效处理界面 扩散带均产生再结晶体,无喷砂时无再结晶产生。同时热处理后界面处出现元素的相互扩散及富 Ta 的 Ni₂Ta 和 Cr₂Ta 相,Ta 在胞状晶内偏聚。

关键词: 热处理; 喷砂; NiCoCrAlYTa 涂层; 镍基单晶高温合金; 再结晶 中图法分类号: TG174.4 文献标识码: A 文章编号: 1002-185X(2009)03-0545-05

单晶高温合金由于具有优良的高温力学性能,被 广泛应用于制造新型航空发动机和燃气轮机的单晶涡 轮叶片。单晶涡轮叶片在苛刻的服役条件下,既要抗 高温腐蚀,又要满足一定的高温力学性能。因此,采 用涂层/单晶高温合金结构,是同时满足两种性能要求 的主要途径之一,即用涂层满足抗高温腐蚀要求与用 单晶为基体满足高温力学性能要求。有关文献表明, 涂层制备过程不当则会对叶片力学性能造成负面影 响。有研究更进一步指出,由于涂层制备过程的因素 引起单晶组织出现大的胞状再结晶组织,这会对单晶 叶片的高温疲劳及持久性能有不利影响^[1~5]。本实验针 对此问题着重研究了制备涂层过程中预处理和后处理 (热处理)对涂层/单晶组织结构的影响,从而为制定控 制和消除单晶表面再结晶的工艺提供依据。

本实验采用低压等离子喷涂技术在镍基单晶高温 合金上制备 NiCoCrAlYTa 涂层。在相同的后处理(热 处理)条件下,进行不同喷砂压力的预处理实验,以研 究预处理制度对涂层/基体界面的影响。在相同的预处 理工艺下,对制备的试样在高温下进行不同后处理(热 处理),以研究热处理制度对涂层/基体界面的影响, 并对相关机制进行探讨。

1 实验方法

基体材料为含 Cr、Co、Mo、W、Ti、Al、Ta 等元 素的镍基单晶高温合金,成分如表 1。喷涂材料为 Ni23Co20Cr8Al0.6Y4.5Ta 粉末。采用低压等离子喷涂 技术制备涂层,涂层厚度约 100 µm,低压等离子喷涂 设备为广州有色金属研究院自行制造的 MPF-1000 型低压等离子喷涂设备。单晶基体试样尺寸为 *Φ*16 mm×3 mm 的圆片,喷涂之前对基体表面进行除油和 喷砂处理,以利于涂层/基体界面的结合。第一批试样 在喷涂前均进行喷砂的预处理,其中喷砂压力约为 0.3 MPa,喷砂角度约 75°。喷涂后的试样,采用 1080 ℃, 6 h; 1080 ℃, 15 h; 1080 ℃, 6 h + 850 ℃, 24 h; 1000 ℃, 6 h 和 850 ℃, 24 h 5 种热处理制度进行真空热处 理,热处理后试样均空冷。另一批试样喷涂前采用 0.4, 0.3, 0.2, 0 MPa 4 种喷砂压力进行预处理,喷涂后均采 用 1080 ℃, 6 h + 850 ℃, 24 h 制度进行真空热处理。

采用 JSM-5910 型扫描电镜(SEM 和 BES)观察涂 层/单晶基体界面微观形貌。并利用能谱仪(EDS)进行 元素分布状况分析。利用 D/Max-RC 型 X 射线衍射 仪(XRD)分析界面区域的物相,并测试了喷砂压力为 0.3 MPa 时,单晶表面的残余应力。采用 JCXA-733 型电子探针及 EPMA-1600 型能谱仪分析了界面微区 元素的分布状况。

2 结果与讨论

2.1 预处理对涂层/基体界面影响

图 1 为采用真空热处理制度均为 1080 ℃, 6 h + 850 ℃, 24 h 条件下,喷砂压力分别为 0.4, 0.3, 0.2, 0 MPa 的试样界面再结晶层的微观形貌背散射电子像 图。由图可知,随着喷砂压力的变化,扩散带再结晶

收稿日期: 2008-09-13

作者简介:梁兴华,男,1973年生,博士生,广东工业大学,广东 广州 510081;通讯作者:周克崧,教授,电话:020-372385203, E-mail: kszhou2004@163.com

层的组织形貌发生变化,在 0.4 MPa 的喷砂压力下(图 la),再结晶体为大菊花状,厚度达 20 μm 左右。与喷 砂压力 0.3 MPa(图 1b)相比,不连续的胞状再结晶体 转变为连续的再结晶层。当喷砂压力降至 0.2 MPa 时, 界面依然出现再结晶体(图 1c),此时再结晶体(约 7 μm) 稍小于 0.3 MPa 下的再结晶体。若无喷砂则界面扩散 带未观察到类似胞状或菊花状再结晶组织。在相同的 真空热处理制度下,再结晶层平均厚度随喷砂压力的 增加而增大(图 2)。

表1 镍基单晶高温合金成分

Table 1 Composition of Ni-based single crystal super-

Element	Cr	Co	Mo	Та	Al	Ti	W	Ni
Content	8.1	5.5	2.2	3.4	6	2	5	Bal.



图 1 试样在 1080 ℃, 6 h+850 ℃, 24 h 热处理条件下不同喷砂压力的界面 BES 图

Fig.1 Cross-sectional BES images of coating/substrate interfaces subjected to different peening pressures followed by heat treatment at 1080 °C for 6 h + 850 °C for 24 h: (a) peening pressure with 0.4 MPa, (b) peening pressure with 0.3 MPa, (c) peening pressure with 0.2 MPa, and (c) no peening pressure



图 2 1080 ℃, 6 h + 850 ℃, 24 h 热处理条件下喷砂压力对试 样再结晶层厚度的影响

Fig.2 Relation of peening pressure (P) and recrystallization layer thickness (δ) under heat treatment at 1080 °C for 6 h+850 °C for 24 h

因此,可以认为在相同的热处理制度条件下,界 面扩散带产生再结晶与喷砂压力密切相关,喷砂压力 越大,再结晶体就越大。

2.2 真空热处理温度对涂层/基体界面影响

试样在制备涂层前的预处理工艺中,喷砂压力均为 0.3 MPa,分别研究试样在1080 ℃,6h;1080 ℃,15h; 1080 ℃,6h+850 ℃,24h和1000 ℃,6h真空热处理 后的界面变化状况。在1080 ℃真空处理6h后试样界面 扩散带出现胞状再结晶组织(图 3a),延长热处理时间至 15h(图 3b),胞状再结晶组织长大闭合。而在1080 ℃热 处理 6 h 后再进行 850 ℃时效处理 24 h, 从图 3c 可看出 胞状晶长大,这种不连续的胞状晶大小约 3~5 µm,厚 度约为 4~5 µm(图 3c)。当热处理温度降至 1000 ℃时, 热处理 6 h 后,扩散带无胞状再结晶体产生(图 3d),仅 进行 850 ℃,24 h 时效处理也无胞状再结晶体产生(图 3e)。以上现象表明,胞状再结晶体的产生机制与真空热 处理温度有关。一些单晶高温合金再结晶的研究也发现 了类似的胞状结构的再结晶。Bond 等人^[5]在低温回火 时,在单晶表面发现了胞状的再结晶体,并认为再结晶 是以不连续的胞状沉淀方式发生的。Burgel 等人^[6]的研 究表明在较低的温度和较大的冷变形条件下,单晶合金 表面会发生再结晶。而图 3f 表明,无涂层的单晶合金表 面在 1080 ℃热处理 6 h 后再进行 850 ℃时效处理 24 h, 并不会发生再结晶。因此,有涂层的单晶在经过热处理 后发生再结晶,除了温度条件外还有其它因素的影响。

一般来说,再结晶是金属经冷变形加工后再加热 至再结晶温度时产生,即通常产生再结晶需要两个条 件即冷变形(或残余应力)和加热至再结晶温度。在制 备涂层前的一些预处理工序(如喷砂)可在单晶表面产 生残余压应力。当用 0.3 MPa 的压力对单晶表面喷砂 约 2 min 后,采用 X 衍射法测试残余应力表明,单晶 表面产生 0.74 GPa 的压应力。而在喷涂涂层时,熔融 粒子以高速(约 300~500 m/s)撞击单晶表面,也可形 成一定的压应力,即产生再结晶的第一个条件。对于 大多数的变形合金材料再结晶温度约为 0.4~0.6 T_m(熔点),而该单晶基体的熔点约为 1380 ℃,则理论 推断的再结晶温度为 828 ℃,可见 1080,1000,850 ℃ 已超过理论再结晶温度,满足再结晶的第二个条件。 然而,在1000和850 ℃扩散带(单晶表面)却无再结晶 产生,可能的原因在于喷砂压力(0.3 MPa)还不足以产 生足够大的冷变形,从而产生再结晶。



图 3 不同真空热处理制度下试样界面 SEM 照片

Fig.3 Cross-sectional SEM image of coating/substrate interfaces under different vacuum heat treatments: (a) 1080 °C, 6 h, (b) 1080 °C, 15 h, (c) 1080 °C, 6 h + 850 °C, 24 h, (d) 1000 °C, 6 h, (e) 850 °C, 24 h, and (f) monocrystal surface with no coating

再结晶优先在界面扩散带(单晶基体表面)形成,然 后向基体(单晶)内部生长,可能有几个方面的原因:(1) 单晶组织为亚稳态结构,有向稳态(多晶)转变的趋势; (2)喷砂产生了从表面至内部的压力应力梯度;(3)界面 (单晶表面)再结晶形核需要克服的能量壁垒远低于基 体(单晶)内部,增加了非均匀形核的几率^[7];(4)涂层 与基体间各元素的相互扩散,使扩散带形成某些元素 的浓度梯度,为再结晶体向基体内长大提供了基础。 2.3 再结晶体的组织分析

图 4、5 是在预处理工艺为喷砂压力 0.3 MPa,真 空热处理制度为 1080 ℃,6 h + 850 ℃,24 h 下的界面 微观形貌背散射电子像图。镍基单晶合金在高温外加 载荷的作用下^[7,8],立方状的 γ'会发生定向粗化,形成 P-型或 N-型筏状组织。在胞状再结晶体的上方小范围





Fig.4 Element distribution of Co, Cr, Al, Ta and W at the coating/ substrate interface: (a) EDS scanning of diffusion area recrystal,(b) element Co distribution, (c) element Cr, (d) element Al, (e) element Ta, and (f) element W

内, 立方状的 y'已经筏化(图 5), 表明在胞状晶的上方 存在一定的应力作用。喷砂预处理工艺是造成 y'筏化 的应力来源, 高温(1080 ℃)热处理导致了 y'筏化。元 素 Co、Cr 和 Al 在胞状晶界面两端含量不同, 胞状晶 内 Co、Cr 和 Al 含量显著高于单晶基体。采用电子探 针对图 5 中各位置进行成分分析, 由分析结果可知(表 2), Ta 元素含量在胞状晶内产生偏聚, 元素 Co、Cr 和 Al 有从涂层向单晶基体扩散的趋势, 而元素 W 则 正相反。显而易见, 基体与涂层各元素的浓度差导致 了高温下元素的相互扩散。





Fig.5 Cross-sectional BES image of diffusion recrystallization

表 2 试样电子探针分析结果

 Table 2
 Compositions of various points in the NiCoCrAlYTa

coating and super-alloy by EPXMA (ω /%)												
Position	Al	Cr	Co	Та	Ti	Mo	W	Ni				
1	5.8	7.6	9.1	4.4	2.0	1.9	4.6	Bal				
2	6.1	11.7	10.6	10.5	0.4	0.9	3.5	Bal				
3	7.4	20.2	14.4	5.8	0.2	0.8	2.8	Bal				
4	8.8	21.1	18.3	4.4	0.1	0.2	0.4	Bal				

为研究界面附近涂层、扩散带和基体物相变化, 采用如图 6 所示的剥层法进行研究。机械剥层后,采 用小角度 X 射线衍射法对各层物相及其变化情况进行 分析。图 7 所示,在离界面 10 μm 的涂层(层 1),除基 本相 γ-Ni、γ'-AlNi₃和 β-NiAl 外,还有金属间化合物 相 AlCo 相和 CrCoTa 相,以γ和β相为主。界面扩散 带(层 2)处,γ'衍射峰增强,并出现了富含 Ta 的 Ni₂Ta 和 Cr₂Ta 相,以及 Cr₄Ni₁₅W 相,该层以γ'相为主。层 3 基体处,γ 衍射峰较γ'增强,出现富含 Cr 的新相 Cr₂(Al, Ti),而富 Ta 相则消失。而层 4 基体的主相为 γ和γ'相,以γ相为主,富 Cr 和W 的相消失。扩散带 中不同于基体与涂层的新物相的出现,说明了基体和 涂层中的各元素,在高温下由高浓度区向低浓度区扩 散,从而导致了新相的形成。

同时上述分析表明,扩散带上的再结晶体与基体和 涂层相比,其组成成分和形态有很大的不同。图 7 界面 扩散带层(层 2)物相分析表明,有富含 Ta 的 Ni₂Ta 相和 Cr₂Ta 相,以及新相 Cr₄Ni₁₅W 相出现,且 y'-AlNi₃相衍 射峰比基体和涂层高。因此,结合图 4 和图 5 的元素分 布和成分分析,可以推断,再结晶体组织的物相以 y' 相为主,并有 Ni₂Ta、Cr₂Ta 和 Cr₄Ni1₅W 的混合相。





Fig.6 Mechanical stripping diagram



Fig.7 XRD patterns of different stripping layer

3 结 论

 涂层/基体界面胞状再结晶体的形成与真空热 处理温度有关。1000 和 850 ℃真空热处理,涂层/基 体界面扩散带处无再结晶体形成,而在 1080 ℃真空 热处理,界面扩散带均有再结晶晶粒形成,晶粒平均 尺寸 3~5 μm,厚度约为 4~5 μm。

2)涂层/基体界面再结晶的形成与喷涂前的预处 理制度有关。经1080 ℃,6h+850 ℃,24h热处理后, 预处理时喷砂压力高于 0.2 MPa 的试样界面扩散带形 成再结晶,无喷砂预处理则不形成再结晶。再结晶层 随喷砂压力的增大而增厚,0.4 MPa 喷砂压力下可达

约 20 µm。

3) 元素 Co、Cr 和 Al 在高温下有从涂层向单晶基体扩散的趋势,而 Ta 则在胞状晶内偏聚。界面扩散带出现富 Ta 的 Ni₂Ta 相和 Cr₂Ta 相。

参考文献 References

- [1] Jia Bo(贾 波), Li Chunguang(李春光), Li Haiyan(李海燕).
 Materials Engineering(材料工程)[J], 2008, 6: 64
- [2] Wang Huaren(王华仁). Heat Treatment of Metals Abroad(国 外金属热处理)[J], 2003, 2: 19
- [3] Xie G, Zhang J, Lou L H. Scripta Materialia[J], 2008, 59: 858

- [4] Chen Rongzhang(陈荣章). Aviation Engineering & Maintenance(航 空制造工程)[J], 1990, 4: 22
- [5] Band S D, Martin J W. Journal of Materials Science[J], 1984, 19: 3867
- [6] Burgel R. Portella P D, J Preuha Super Alloys 2000[C]. Warrendale, PA: TMS, 2000: 229
- [7] Li Yanan(李亚楠), He Di(何 迪), Li Shusuo(李树索) et al. Acta Metallurgica Sinica(金属学报)[J], 2008, 4: 391
- [8] Shui Li(水 丽), Tian Sugui(田素贵), Jin Tao(金 涛) et al. Rare Metal Material and Engineering(稀有金属材料与工程)[J], 2007, 36(1): 47

Recrystallization on Interface between NiCoCrAlYTa Coating and Nickel-Based Super-Alloy

Liang Xinghua^{1, 2}, Zhou Kesong², Liu Min², Deng Changguang²

(1. Guangdong University of Technology, Guangzhou 510081, China)

(2. Guangzhou Research Institute of Non-ferrous Metals, Guangzhou 510650, China)

Abstract: The NiCoCrAlYTa coating was prepared on Ni-based single crystal super-alloys by low pressure plasma spraying (LPPS). The influences of heat treatment and pre-peening on the interface recrystallization of NiCoCrAlYTa coating and nickel-based super-alloy substrate were investigated by X-ray, SEM, BES and EPXMA. It was found that cellular recrystallization occurred at the diffusion area of samples adopting the vacuum heat treatment at the temperature of 1080 °C, while no recrystallization appeared at the temperatures of 1000 °C and 850 °C. Recrystallization was also observed in the sample subjected by pre-peening with more than 0.2 MPa, followed by 1080 °C, 6 h heat treatment and 850 °C, 24 h aging treatment, while no recrystallization was observed in the sample subjected by no pre-peening followed by above mentioned heat treatment. The results revealed that element Ta aggregated within cellular grains and that inter-diffusion took place and Ta-rich phases (Ni₂Ta, Cr₂Ta) were formed at the interface through heat treatment.

Key words: heat treatment; peening; NiCoCrAlYTa coating; Ni-based single crystal super-alloys; recrystallization

Biography: Liang Xinghua, Candidate for Ph. D., College of Materials and Energy, Guangdong University of Technology, Guangzhou 510081, P. R. China